SEST AVAILABLE COPY

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

An:					PCT
	siehe Formular PCT/ISA/220 22 Manak = 15.10			SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE 2. USTUS (Regel 43bis.1 PCT)	
				Absendedatum	he Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)
	nzeichen des Anmeld e Formular PCT/			WEITERES VORO	GEHEN
	nationales Aktenzeich /DE2004/002657		Internationales Anmelded 03.12.2004	latum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i> 15.12.2003
	nationale Patentklass K17/16	sifikation (IPK) ode	er nationale Klassifikation u	nd IPK	
Anme	elder INEON TECHNO	DLOGIES AG			
1.	Dieser Beschei	d enthält Anga	aben zu folgenden Pui	nkten:	
	⊠ Feld Nr. I	Grundlage des	Bescheids		
	☐ Feld Nr. II	Priorität			
	☐ Feld Nr. III	•		er Neuheit, erfinderisc	he Tätigkeit und gewerbliche
	☐ Feld Nr. IV	•	nheitlichkeit der Erfindun		
	☑ Feld Nr. V	Begründete Fe	eststellung nach Regel 4	3 <i>bis</i> .1(a)(i) hinsichtlicl	h der Neuheit, der erfinderischen Tätigke
		und der gewer	blichen Anwendbarkeit;	Unterlagen und Erklä	rungen zur Stützung dieser Feststellung
	☐ Feld Nr. VI	Bestimmte and	geführte Unterlagen		
•			ngel der internationalen		
•	☐ Feld Nr. VIII	Bestimmte Be	merkungen zur internatio	onalen Anmeldung	
2.	WEITERES VOI	RGEHEN	•		
	mit der internation	onalen vorläufige nörde als diese a	en Prüfung beauftragten als IPEA wählt und die g	Behörde ("IPEA"); die ewählte IPEA dem Int	scheid als schriftlicher Bescheid der es trifft nicht zu, wenn der Anmelder ernationale Büro nach Regel 66.1bis b) ehörde nicht anerkannt werden.
	aufgefordert, be wurde oder vor	i der IPEA vor A Ablauf von 22 M	blauf von 3 Monaten ab	dem Tag, an dem da sdatum, je nachdem,	EA gilt, so wird der Anmelder s Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt welche Frist später abläuft, eine chen.
	Weitere Optione	en siehe Formbla	att PCT/ISA/220.		
3.	Nähere Einzelh	eiten siehe die A	Anmerkungen zu Formbl	att PCT/ISA/220.	

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016 Bevollmächtigter Bediensteter

Meulemans, B

Tel. +31 70 340-8905



SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/002657

	Feld Nr. I Grundlage des Bescheids				
1.	Hinsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.				
	Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).				
2.	Hinsichtlich der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz , die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:				
	a. Art des Materials				
	□ Sequenzprotokoll				
	☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll				
	b. Form des Materials				
	☐ in schriftlicher Form				
	☐ in computerlesbarer Form				
	c. Zeitpunkt der Einreichung				
	☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten				
	□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht				
	☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht				
3.	. U Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimn bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.				
4	Zusätzliche Bemerkungen:				

Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der Feld Nr. V erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit

Ja: Ansprüche 1-24

Nein: Ansprüche keine

Erfinderische Tätigkeit

Ja:

Ansprüche 2,3,12,16,20-24

Nein: Ansprüche 1,4-11,13-15,17-19

Gewerbliche Anwendbarkeit

Ja:

Ansprüche: 1-24

Nein: Ansprüche: keine

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung Feld Nr. VII

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V.

)

- 1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
 - D1: KLUMPERINK E A M ET AL: "REDUCING MOSFET 1/F NOISE AND POWER CONSUMPTION BY SWITCHED BIASING" IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, IEEE INC. NEW YORK, US, Bd. 35, Nr. 7, Juli 2000 (2000-07), Seiten 994-1001, XP001100951 ISSN: 0018-9200
 - D2: DE 100 45 148 A1 (HELLA KG-HUECK &; CO) 28. März 2002 (2002-03-28)
- Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1, 4 bis 11, 13 bis 15 und 17 bis 19 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.
- 2.1 Das Dokument D1, wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

Transistor-Anordnung zum Verringern von Rauschen (Zusammenfassung), mit einem ersten Feldeffekttransistor (Abb.2,4), der einen Source-Anschluss und einen Drain-Anschluss aufweist (Abb.2, Abb.4) sowie einen Steuer-Anschluss (Abb.2,4 Gate) zum Anlegen eines ersten Signals oder eines zweiten Signals (Abb.2,4(Switched Bias)); mit einer Taktgeber-Einheit (Abb.2,4), die mit dem Feldeffekttransistor derart gekoppelt ist, dass sie den Feldeffekttransistor an dessen Steueranschluss alternierend das erste Signal und das zweite Signal bereitstellt (S.996-997, Paragraph 'B. Switched Biasing Technique'; Abb.4) mit einer Alternier-Frequenz, die mindestens so groß ist wie die Eckfrequenz der Rauschcharakteristik des Feldeffekttransistors, oder mit einer reziproken Alternier-Frequenz, die kleiner ist als eine mittlere Lebensdauer eines Besetzungszustands einer Störstelle im Grenzbereich zwischen Kanal-Bereich und Gate-isolierender Schicht des Feldeffekttransistors (S.996-997; Paragraph 'IV. Switched Biasing: Reduce 1/f Noise Itself'; Abb.3; Abb.10).

2.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem aus D1

- bekannten dadurch, dass Anspruch 1 zwei parallel geschaltete Transistoren beschreibt, wobei die Transistoren gegenphasig angesteuert werden.
- 2.3 Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, dass besagte Schaltung kontinuierlich Strom führt. Das Dokument D1 offenbart diese Aufgabe auch (S.997, Linker Spalte, Z.14-16).
- 2.4 Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Lösung kann aus folgenden Gründen nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT): mehrere Transistoren zu verwenden, um die gestellte Aufgabe zu lösen, ist dem Fachmann hinreichend bekannt. Das Dokument D2 offenbart, zum Beispiel, eine Schaltung mit zwei parallele Transistoren und eine alternierenden Steuerung (Zusammenfassung; Abb.(T1,T2))
- 2.5 Daher würde der Fachmann, ohne erfinderisches Zutun, alle in D1 und D2 offenbarten Merkmale miteinander kombinieren, um die gestellte Aufgabe zu lösen. Die im unabhängigen Anspruch 1 vorgeschlagene Lösung kann daher nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33 (3) PCT).
- 2.6 Die Dokumente D1 und D2 offenbaren weiter:
- 2.6.1 (Anspr.2,3) dass der Steuer-Anschluss ein Gate-Anschluss ist (D1, Abb.4) (siehe auch Paragraph 3.1 und Punkt VII); und
- 2.6.2 (Anspr.4) Nutzsignale und Referenzpotentiale für das erste und das zweite Signal (D1, Abb.2, Abb.4); und
- 2.6.3 (Anspr.5,8) baugleiche Transistoren (D2, Paragraph 0008, implizit); und
- 2.6.4 (Anspr.6) das alternierende Anlegen des ersten und des zweiten Signals, mit einer Alternier-Frequenz größer als die Frequenzen eines Nutz-Frequenzbands eines zugeordneten Schaltkreises (D1, S.997-999, Paragraphen 'V.Applying Switched Biasing' und 'VI.Experimental Results'); und

- 2.6.5 (Anspr.7) ein Substrat-Anschluss als Wannen-Anschluss (D1, implizit bei den meisten Feldeffekttransistoren); und
- 2.6.6 (Anspr.9) die Alternierung der Inversions-Arbeitspunkte und Akkumulations-Arbeidspunkte (D1, S.996, Linker Spalte, Z.29-40; Abb.2); und
- 2.6.7 (Anspr.10,11,15) zwei Schaltelemente, welche mit dem ersten bzw. zweiten Feldtransistor gekoppelt sind und welche mit einer Alternier-Frequenz schaltbar sind (D2, Abb.2) und alternierend das erste oder das zweite Signal anlegen (D1, Abb.4); und
- 2.6.8 (Anspr.13) die Anwendung in Analog-Schaltungstechnik (D1, S.997-999, Paragraph 'V.Applying Switched Biasing'); und
- 2.6.9 (Anspr.17,18) die Anwendung in einem integrierten Schaltkreis (D1, S.997-999, Paragraph 'V.Applying Switched Biasing').
- 2.7 (Anspr.14) Ferner ist die Anwendung von mehreren (mehr als zwei) Transistoren schon im Fachgebiet der Elektronik bekannt.
- 2.8 Anspruch 19 definiert die dem Gegenstand des Anspruchs 1 entsprechenden Verfahren. Die Bedenken gegen letzeren treffen deshalb auch auf den Anspruch 19 zu.
- Das zusätzliche Merkmal der Verwendung des Substrat-Anschlusses nach Ansprüche 2 und 20 und die zusätzlichen Merkmale der Ansprüche 3, 12, 16 und 21 bis 24 sind aus dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch werden sie durch ihn nahegelegt.

Zu Punkt VII.

)

Die Merkmale der Ansprüche sind nicht mit in Klammern gesetzten Bezugszeichen versehen worden (Regel 6.2 b) PCT).

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT) Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/002657